

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成29年2月23日(2017.2.23)

【公開番号】特開2015-141255(P2015-141255A)

【公開日】平成27年8月3日(2015.8.3)

【年通号数】公開・登録公報2015-049

【出願番号】特願2014-12823(P2014-12823)

【国際特許分類】

G 09 F	9/30	(2006.01)
G 09 G	3/30	(2006.01)
G 09 G	3/20	(2006.01)
H 01 L	51/50	(2006.01)
H 01 L	27/32	(2006.01)
H 05 B	33/02	(2006.01)

【F I】

G 09 F	9/30	3 3 8
G 09 G	3/30	J
G 09 G	3/20	6 2 4 B
G 09 G	3/20	6 8 0 G
G 09 G	3/20	6 2 1 M
H 05 B	33/14	A
G 09 F	9/30	3 6 5
H 05 B	33/02	

【手続補正書】

【提出日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板の上側に、第1チャネル部を含んで形成された第1半導体層と、

前記基板の上側に、第1容量電極を含んで形成された第2半導体層と、

前記第1半導体層及び前記第2半導体層の上側に形成された第1絶縁層と、

前記第1絶縁層の上側に、第1ゲート電極の一部と、第2容量電極の一部と、を含んで形成された第3半導体層と、

前記第3半導体層の上側に形成された第2絶縁層と、

前記第2絶縁層の上側に形成された、有機EL発光素子のアノード電極と、
を含み、

前記第1チャネル部、前記第1絶縁層及び前記第1ゲート電極は、駆動トランジスタの
一部を構成し、

前記第2半導体層、前記第1絶縁層及び前記第2容量電極は、第1容量の少なくとも一部を構成し、

前記第3半導体層は、平面視において、前記第1絶縁層、前記第1半導体層及び前記第2半導体層と重畠し、

前記アノード電極は、平面視において、前記第1絶縁層及び前記第1乃至第3半導体層

と重畳する、

ことを特徴とする発光素子表示装置。

【請求項 2】

前記第2絶縁層と前記アノード電極の間にそれぞれ形成された第3容量電極及び走査信号線をさらに含み、

前記第2絶縁層は、前記第3半導体層と前記アノード電極の間に配置され、

前記第3容量電極は、前記第2半導体層と電気的に接続され、

前記走査信号線は、第2ゲート電極を含み、

前記第3半導体層は、第2チャネル部を含み、

前記第3半導体層、前記第2絶縁層及び前記第3容量電極は、前記第1容量の少なくとも一部を構成し、

前記第2チャネル部、前記第2絶縁層及び前記第2ゲート電極は、画素トランジスタの一部を構成する、

ことを特徴とする請求項1に記載の発光素子表示装置。

【請求項 3】

前記第3容量電極は、平面視において、前記第1絶縁層、前記第1半導体層及び前記第2半導体層と重畳し、

前記アノード電極は、平面視において、前記第3容量電極と重畳し、

前記画素トランジスタは、平面視において、前記アノード電極の外側に配置された領域を含む、

ことを特徴とする請求項2に記載の発光素子表示装置。

【請求項 4】

前記第3容量電極及び前記走査信号線の上側に形成された第3絶縁層と、

前記第3絶縁層の上側に形成された高基準電位線と、

をさらに含み、

前記高基準電位線は、平面視において、前記第2半導体層、前記第3半導体層及び前記第3容量電極のそれぞれの一部と重畳し、

前記高基準電位線は、前記駆動トランジスタと電気的に接続される、

ことを特徴とする請求項3に記載の発光素子表示装置。